

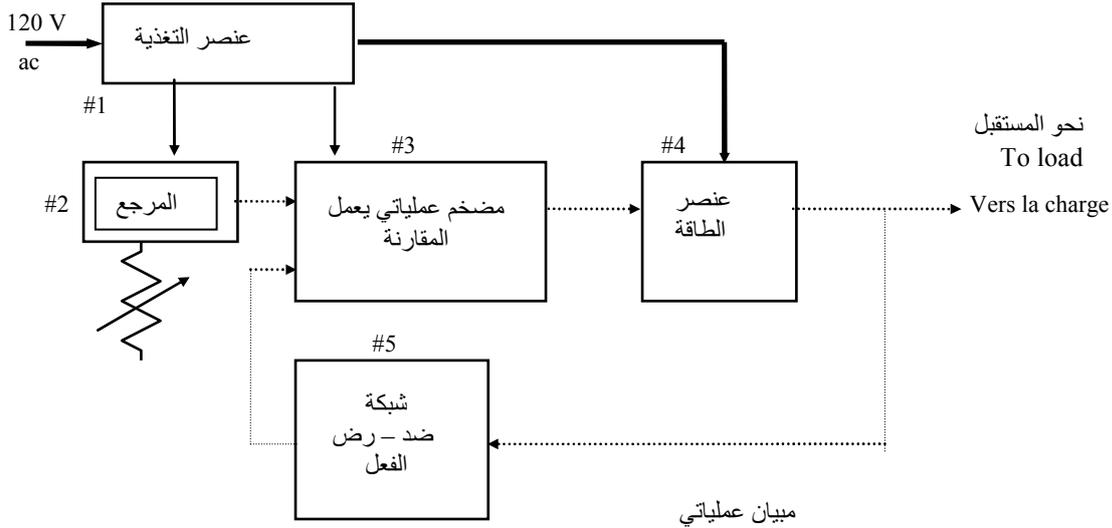
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إعداد : احمد زهار

1. الترانزيستور (القاعدة) :**1.1 مضخم تيار لمضخم توتر****1.1.1 دور الترانزيستور**

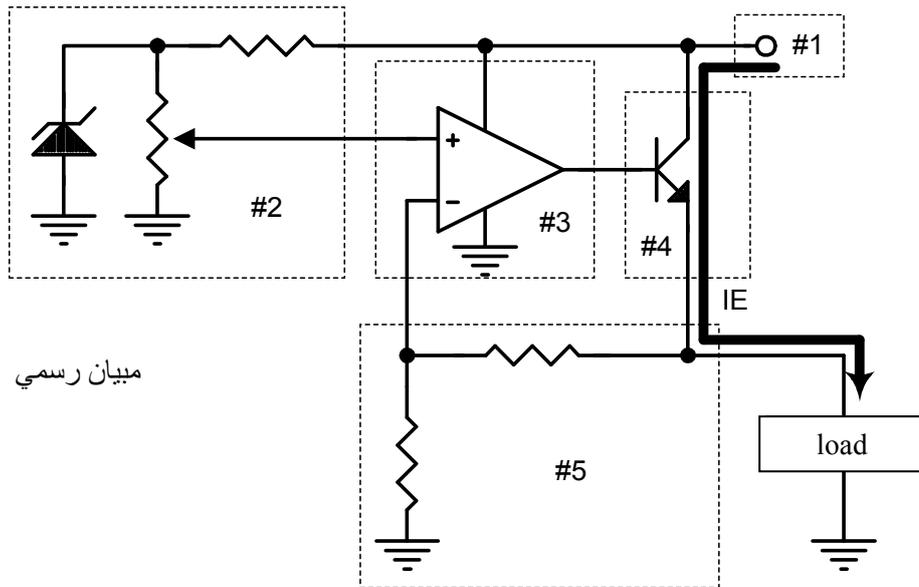
إن تيار مضخم عملياتي محدود، مثلا 741C يعطي فقط 20 mA. فإذا كان المستقبل يطلب أكثر من ذلك فيجب التفكير في مضخم التيار.

الشكل أسفله يمثل تبيانه لتغذية منظمة



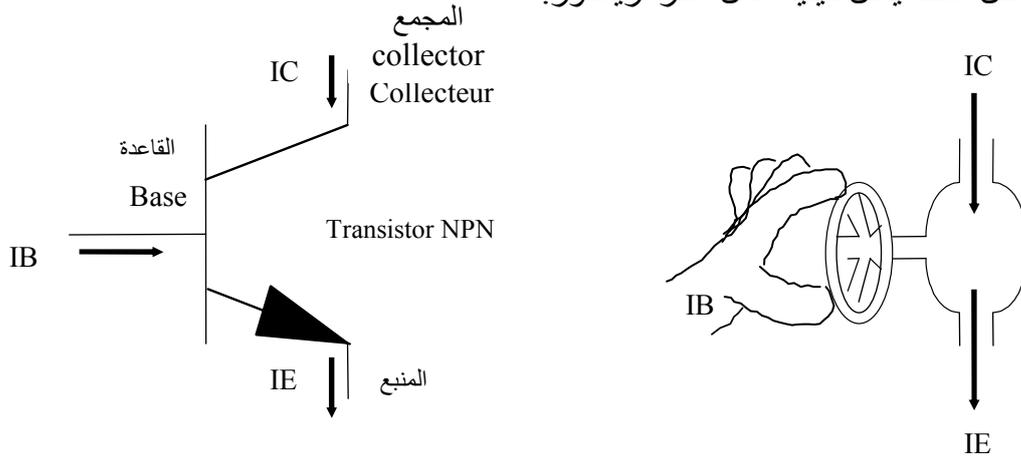
الشكل 1

لنركز على عنصر القدرة (#4). العنصر ليس سوى ترانزيستور يقوم بتضخيم التيار فهو يزود المستقبل بالتيار الكافي من منبع التغذية (#1) حسب تحكم مضخم العملياتي. وذلك تحت مراقبة دوائر المراقبة #2, #3 و#5.



الشكل 2

الشكل أسفله يمثل كيفية عمل الترانزيستور.



الشكل 3

مضخم العمليات هو الذي يمد القاعدة بالتيار I_B الذي يتحكم في تيار المجمع I_C و المفرق I_E . إن التيار I_C هو التيار I_B مضاعف بالعامل β . إن ترانزيستور عادي يكون فيه β يساوي 100.

$$I_C = \beta \times I_B$$

التيار I_E ليس إلا مجموع I_B و I_C (قانون العقد)

$$I_E = I_C + I_B$$

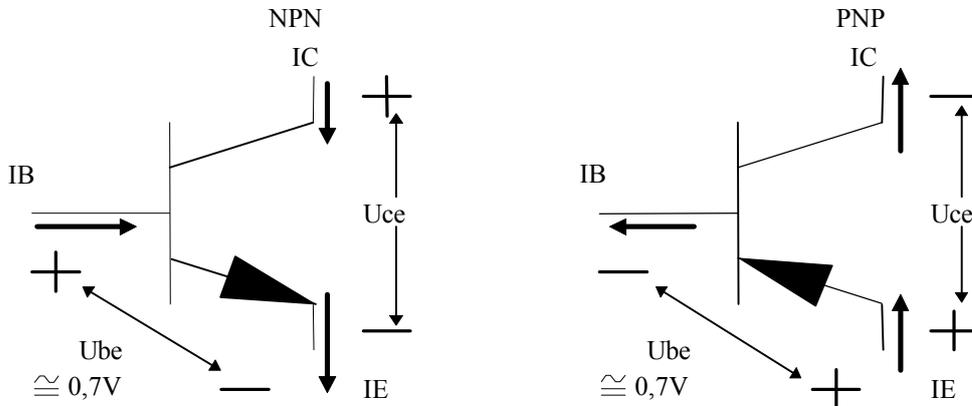
من المعادلتان السابقتان نستنتج :

$$I_E = I_B + \beta I_B$$

$$I_E = I_B \times (\beta + 1) \text{ إذن:}$$

$$I_B = I_E / (\beta + 1) \text{ و كذلك:}$$

باختصار:



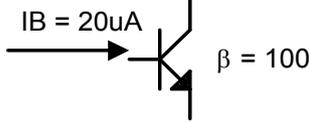
الشكل 4

$$I_C = \beta \times I_B \text{ (اشتغال الترانزيستور)}$$

$$I_E = I_C + I_B \text{ (قانون العقد)}$$

$$I_E = (\beta + 1) \times I_B$$

أمثلة :



احسب :

$$I_C = ?$$

$$I_E = ?$$

الحل :

$$I_C = \beta \times I_B = 100 \times 20\mu A = 2mA$$

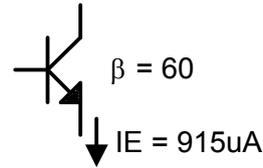
$$I_E = I_C + I_B = 2mA + 20\mu A = 2.02mA$$

مثال :

- 1 #

$$I_B = ?$$

$$I_C = ?$$



$$I_B = I_E / (\beta + 1) = 915\mu A / (60 + 1) = 15\mu A$$

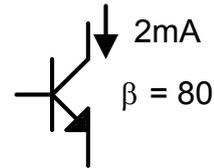
$$I_C = \beta \times I_B = 60 \times 15\mu A = 900\mu A \text{ ou encore } I_C = I_E - I_B = 915\mu A - 15\mu A = 900\mu A$$

مثال :

- 2 #

$$I_B = ?$$

$$I_E = ?$$



$$I_B = I_C / \beta = 2mA / 80 = 25\mu A$$

$$I_E = I_C + I_B = 2mA + 25\mu A = 2.025mA$$

مثال :

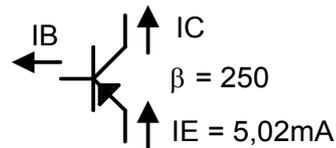
- 3 #

$$I_B = ?$$

$$I_C = ?$$

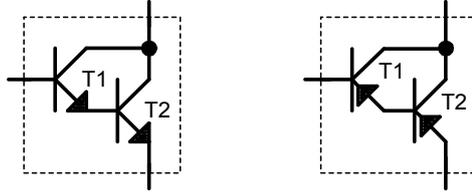
$$I_B = I_E / (\beta + 1) = 5.02mA / 251 = 20\mu A$$

$$I_C = \beta \times I_B = 250 \times 20\mu A = 5mA$$



1.2 تركيبية دارلينتون DARLINGTON

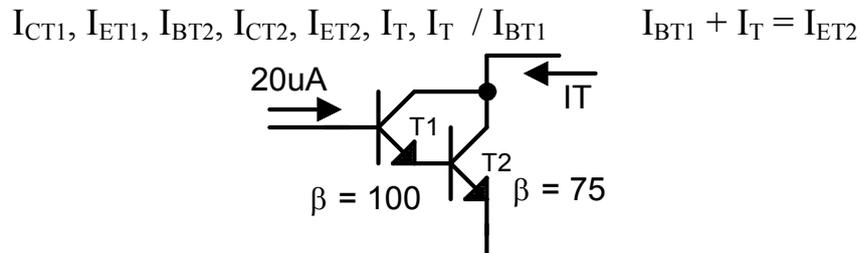
يمكن جمع ترانزيستورين، و ذلك للحصول على معامل تضخيم كبير. فالمبدأ يقوم على أساس أن التيار المضخم من طرف الترانزيستور الأول I_{ET1} يتحكم في عمل الثاني. أي أن تيار المفرق في الترانزيستور الأول I_{ET1} المضخم بالمعامل β هو تيار القاعدة في الثاني I_{BT2} وبالتالي تيار قاعدة كبير نحصل على تضخيم أكبر.



الشكل 5: تركيبية دارلينتون

مثال :

احسب ؟:



الحل :

$$I_{CT1} = \beta \times I_{BT1} = 100 \times 20\mu A = 2mA$$

$$I_{ET1} = I_{BT1} + I_{CT1} = 2mA + 20\mu A = 2.02mA$$

$$I_{BT2} = I_{ET1} = 2.02mA$$

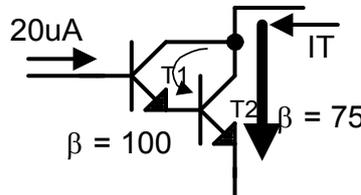
$$I_{CT2} = I_{BT2} \times \beta = 2.02mA \times 75 = 151.5mA$$

$$I_{ET2} = I_{BT2} + I_{CT2} = 2.02mA + 151.5mA = 153.52mA$$

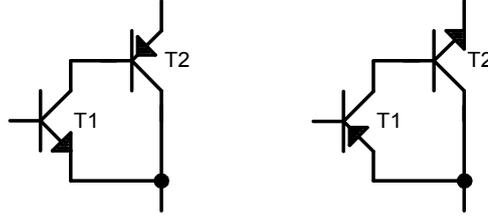
$$I_T = I_{CT1} + I_{CT2} = 2mA + 151.5mA = 153.5mA$$

$$I_T / I_{BT1} = 153.5mA / 20\mu A = 7675$$

$$20\mu A + 153.5mA = 153.52mA \text{ !!! (أي عقدة)}$$



1.3 تركيبية ألفا (أي دارلينتون متكامل) (ALPHA (complementary darlington))

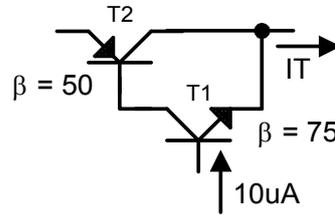


الشكل 6 : تركيبية ألفا

مثال:

1 -

احسب : I_{CT1} , I_{ET1} , I_{BT2} , I_{CT2} , I_{ET2} , I_T .



الحل :

$$I_{CT1} = 10\mu A \times 75 = 750\mu A$$

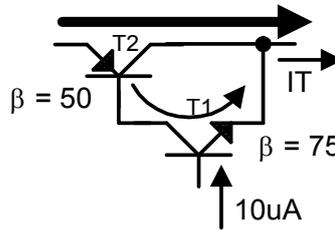
$$I_{ET1} = 10\mu A + 750\mu A = 760\mu A$$

$$I_{BT2} = I_{CT1} = 750\mu A$$

$$I_{CT2} = 750\mu A \times 50 = 37.5mA$$

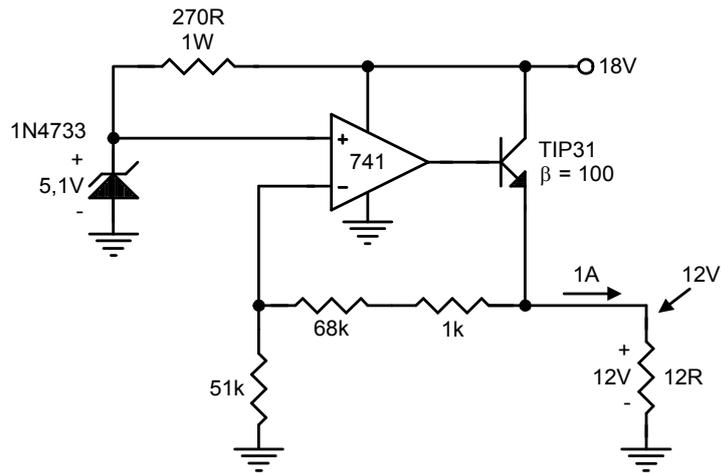
$$I_{ET2} = 37.5mA + 750\mu A = 38.25mA$$

$$I_T = I_{CT2} + I_{ET1} = 37.5mA + 760\mu A = 38.26mA$$

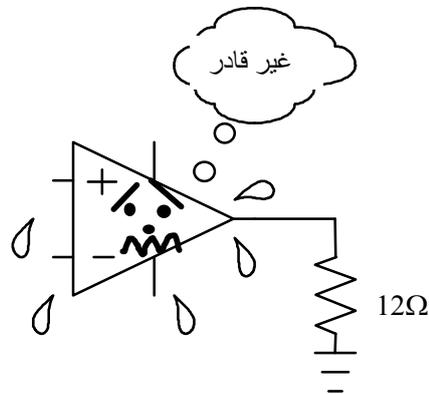


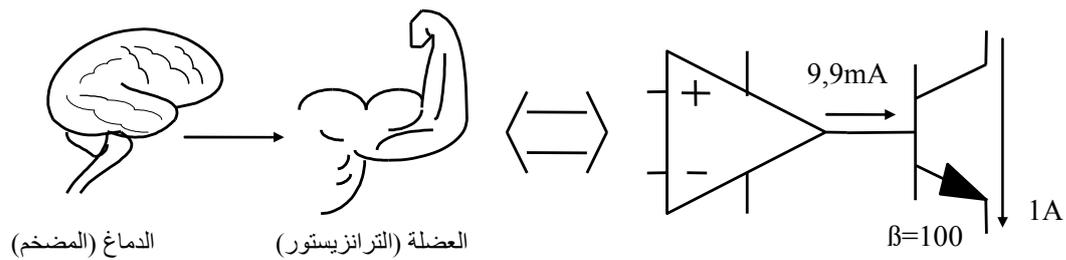
1.4 تركيب ترانزيستور مع مضخم عملياتي

الشكل أسفله عبارة دارة بسيطة للتحكم في الترانزيستور بواسطة مضخم عملياتي حتى يتسنى تزويد المستقبِل بتيار كافي ، و ذلك لعجز المضخم ألعلياتي عنه.

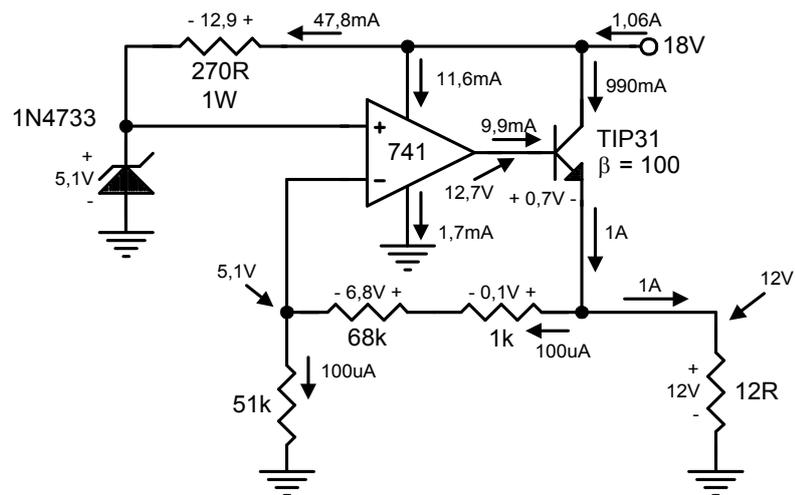


المستقبل (12Ω) يستهلك 1 امبير و مضخم عملياتي عادي قدرته هي 20mA. إذن دور الترانزيستور هو المساعدة.





الشكل 7: مقارنة للدارة مع الإنسان



التيار 1.7mA هو تيار تغذية المضخم.